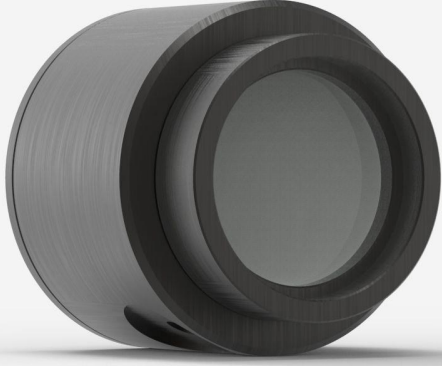


PH100-SI-HA-OD1-D0

최대 300 mW의 레이저 파워 계측용 광전다이오드 검출기.



제품군 주요 특징

LARGE APERTURES

10 mm Ø for the silicon sensors

3 VERSIONS

- Silicon 350 - 1080 nm, up to 750 mW
- Silicon-UV 210 - 1080 nm, up to 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, up to 500 mW

CHOICE OF ATTENUATORS

- OD0.3: 50% transmission (for PH100-SI^{UV} only)
- OD1: 10% transmission
- OD2: 1% transmission

HIGH ACCURACY

The new PH100-SI-HA presents the lowest calibration uncertainty to date.

PRECISE CALIBRATION

Wavelength selection in 1 nm steps

SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

[STAND-D-233](#)

사양

계측 성능	
최대 평균 파워 ¹	300 mW
등가노이즈파워 (NEP) ²	200 pW
스펙트럼 범위	400 - 1080 nm
일반 상승 시간	0.2 s
파워 교정 불확정성 ³	±5.0 % (400 - 419 nm) ±4.0 % (420 - 899 nm) ±5.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
첨두 감도	980 nm
최소 반복률 ⁴	155 kHz
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1064nm의 감쇠기. 다른 파장에서의 최대 출력 곡선을 참조하십시오. 2. 980nm. 액면 값. 실제 값은 환경의 전자파 간섭 및 파장에 따라 달라집니다. 3. 감쇠기. 비감쇠기 교정에 대하여 불확실할 경우 사용자 설명서를 참조하십시오. 4. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도	100 W/cm ²
물리적 특성	
구경 지름	10 mm
업소버	Si
치수	38.1Ø x 36D mm
중량	0.14 kg
센서면까지의 거리	13.7 mm

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.